

LPQBE46C

产品特性 Product Features :

芯片尺寸 Dimensions :

46mil x 46mil (1168±50μm x 1168±50μm)

芯片厚度 Chip Thickness : 6 mil(150±20μm)

焊盘尺寸 Pad Size :

P 焊盘 (P PAD) : 17.2mil x 39.1mil

(431±30μm x 978±50μm)

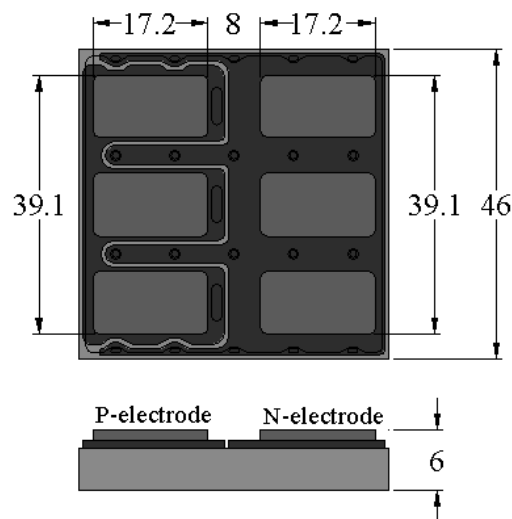
N 焊盘 (N PAD) : 17.2mil x 39.1mil

(431±30μm x 978±50μm)

焊盘金属 Pad Material :

P 焊盘 (P PAD) : AuSn

N 焊盘 (N PAD) : AuSn



单位: mil

光电性能 (Electronic Parameters),TA=25°C						
参数 Parameters	符号 Symbol	条件 Condition	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
开启电压 Turn-On Voltage	Vf1	If=10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压 Forward Voltage	Vf2	If=700mA	2.8	3.0	3.3	V
反向漏电流 Reverse Leakage Current	IR	Vr=5V	---	---	2	μA
主波长 Dominate Wavelength	λd	If=350mA	445	---	465	nm
半波宽度 FWHM	Δλ	If=350mA	---	---	30	nm
光功率 Luminous Power	Po	If=350mA	540	---	720	mW